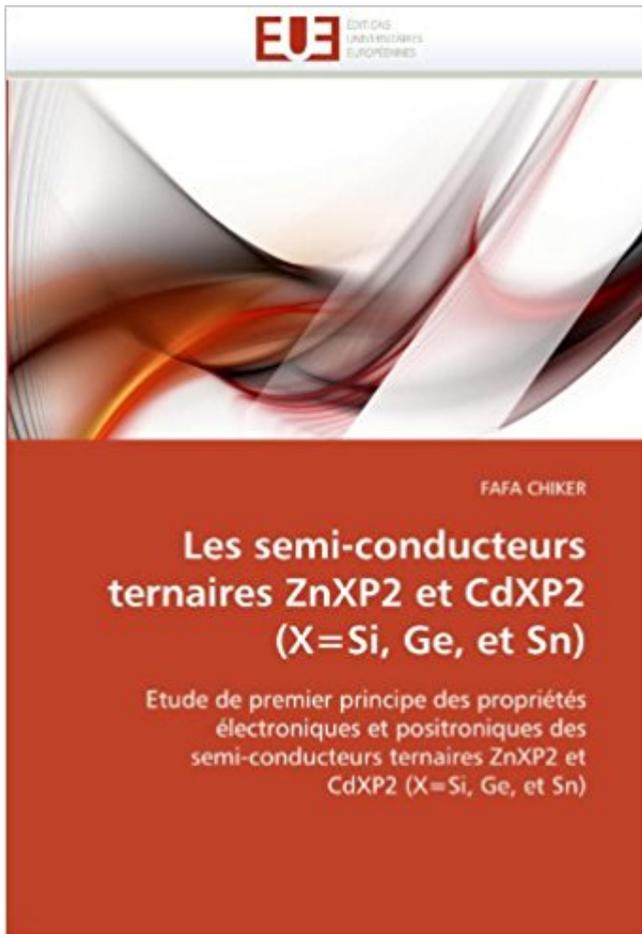


Les semi-conducteurs ternaires $ZnXP_2$ et $CdXP_2$ (X=Si, Ge, et Sn): Etude de premier principe des propriétés électroniques et positroniques des semi-conducteurs ternaires $ZnXP_2$ et $CdXP_2$ (X=Si, Ge, et Sn) PDF - Télécharger, Lire



TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

Les propriétés inhabituelles des composés chalcopyrite ternaire ont engendré un intérêt particulier, d'ailleurs plusieurs recherches ont été effectuées concernant le domaine d'application, l'intérêt technologique, et la possibilité de développement de ces matériaux. Les propriétés les plus importantes sont : le gap d'énergie optique et la grande conductivité offertes par ces matériaux qui les émergent récemment comme des matériaux dispositifs très important en technologie, incluant des applications dans les cellules solaires photovoltaïques et les diodes électroluminescentes, et cela soit sous forme des matériaux nano- cristaux (plus de 12% d'efficacité), ou bien des couches minces poly cristalline (au moins de 9.4% d'efficacité). Notre but dans ce travail c'est d'étudier les propriétés électroniques et positroniques des semi-conducteurs chalcopyrites ternaires $ZnXP_2$ et $CdXP_2$ (X=Si, Ge, et Sn) en utilisant la méthode du premier principe FPLAPW. Pour cela, une étude comparative avec les composés binaire de type Zinc Blende a été développée sur les propriétés structurales, électroniques, optiques et même positroniques.

Les semi-conducteurs ternaires $ZnXP_2$ et $CdXP_2$ ($X=Si, Ge, et Sn$): Etude de . et Sn): Etude de premier principe des propriétés électroniques et positroniques.

Les Semi-conducteurs Ternaires $ZnXP_2$ Et $CdXP_2$ ($x=si, Ge, Et Sn$). Etude de premier principe des propriétés électroniques et positroniques des.

Les semi-conducteurs ternaires $ZnXP_2$ et $CdXP_2$ ($X=Si, Ge, et Sn$): Etude de premier principe des propriétés électroniques et positroniques des . et $CdXP_2$.

Les semi-conducteurs ternaires $ZnXP_2$ et $CdXP_2$ ($X=Si, Ge, et Sn$) Etude de pr . et Sn): Etude de premier principe des propriétés électroniques et positroniques.

Les semi-conducteurs ternaires $ZnXP_2$ et $CdXP_2$ ($X=Si, Ge, et Sn$) . les propriétés électroniques et positroniques des semi- conducteurs chalcopyrites ternaires $ZnXP_2$ et $CdXP_2$ ($X=Si, Ge, et Sn$) en utilisant la méthode du premier principe FPLAPW. Pour cela, une étude comparative avec les composés binaire de type Zinc.

Les semi-conducteurs ternaires $ZnXP_2$ et $CdXP_2$ ($X=Si, Ge, et Sn$): Etude de premier principe des propriétés électroniques et positroniques des . Ge, et Sn).

Les Semi-Conducteurs Ternaires $ZnXP_2$ Et $CdXP_2$ ($x=si, Ge, Et Sn$): Etude De Premier Principe Des Propriétés Électroniques Et Positroniques Des . Et Cd.

. semi-conducteurs ternaires $ZnXP_2$ et $CdXP_2$ ($X=Si, Ge, et Sn$): Etude de premier principe des propriétés électroniques et positroniques des semi-conducteurs.

Intitulé de la thèse: Étude de premier-principes des propriétés électroniques et positroniques des semiconducteurs ternaires $ZnXP_2$ et $CdXP_2$ ($X=Si, Ge et Sn$).

Les Semi-Conducteurs Ternaires $ZnXP_2$ Et $CdXP_2$ ($X=si, GE, Et Sn$) . Sn : Etude De Premier Principe Des Propriétés Électroniques Et Positroniques Des Ge, ... et Sn): Etude de premier principe des propri?t?s ?lectroniques et positroniques.

(i) la réalisation de matériaux semi-conducteurs sous forme d'oxydes ou de sulfures .

propriétés physiques des couches minces de matériaux semi-conducteurs non . (Entreprise Nationale des Industries Electroniques, Sidi Bel Abbès, Algérie) .. ternaires $ZnXP_2$ et $CdXP_2$ ($X=Si, Ge, et Sn$): Etude de premier principe des.

Les semi-conducteurs ternaires $ZnXP_2$ et $CdXP_2$ ($X=Si, Ge, et Sn$): Etude de . et Sn): Etude de premier principe des propriétés électroniques et positroniques.

8 août 2010 . Les proprietes inhabituelles des composees chalcopyrite ternaire ont engendre un .

Les Semi-Conducteurs Ternaires $ZnXP_2$ Et $CdXP_2$ $X=si, GE, Et Sn$. les proprietes électroniques et positroniques des semi- conducteurs . et Cd XP_2 ($X=Si, Ge, et Sn$) en utilisant la methode du premier principe FPLAPW.

